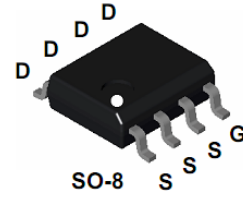


LYPM4463SP (进口芯片)型 P 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 参照执行标准: QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式: S0-8
- 开关速度快, 输入阻抗高, 驱动功耗小, 安全工作区宽, 温度稳定性好
- 产品为非国产化



极限参数

- 贮存温度 T_{stg} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 T_{amb} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过 260°C , 焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 P_D (W)	漏源电压 BV_{DSS} (V)	栅源电压 V_{GS} (V)	漏极电流 I_D (A)	导通电阻 R_{DS} ($m\Omega$)	热阻 $R_{th(j-a)}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
LYPM4463SP	1.5 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	-20	± 12	-9.8 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	11	42

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=-250\mu\text{A}$	-20	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS1}	$V_{DS}=-20\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	-1.0	μA
	I_{DSS2}	$V_{DS}=-20\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_J=70^{\circ}\text{C}$	—	—	-10	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=-12\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	-100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=12\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=-250\mu\text{A}$	-0.6	—	-1.4	V
导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=-10\text{V}, I_D=-13.7\text{A}$	—	—	11	$m\Omega$
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=-4.5\text{V}, I_D=-12.3\text{A}$	—	—	14	$m\Omega$
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=-10\text{V}, I_D=-13.7\text{A}$	15	—	—	S
开启时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=-10\text{V}, I_D=-1\text{A}, V_{GEN}=-4.5\text{V}$	—	—	55	ns
	t_r	$V_{DD}=-10\text{V}, I_D=-1\text{A}, V_{GEN}=-4.5\text{V}$	—	—	90	ns

关断时间	$t_{d(off)}$	$V_{DD}=-10V, I_D=-1A, V_{GEN}=-4.5V$	—	—	170	ns
	t_f	$V_{DD}=-10V, I_D=-1A, V_{GEN}=-4.5V$	—	—	115	ns

S0-8 封装尺寸图

